



美光推出全球首款基於 176 層 NAND 的行動解決方案，打造光速般的 5G 體驗

July 30, 2021 at 11:00 AM CST

美光行動儲存裝置中的先進 3D NAND 可實現豐富、順暢的多媒體體驗

2021 年 7 月 29 日，美國愛達荷州博伊西 — 美光科技 (Nasdaq: MU) 今日宣布全球首款採用 [176 層 NAND](#) 的通用快閃記憶體儲存 UFS 3.1 行動解決方案已正式量產出貨。透過較前幾代快 75% 的循序寫入和隨機讀取性能，專為高階和旗艦級手機打造的美光 UFS 3.1 獨立行動通用快閃記憶體將能徹底釋放 5G 的潛力，[\[1\]](#)在短短 9.6 秒內完成一部兩小時的 4K 電影[\[2\]](#)下載。

美光的 176 層 NAND 設計精巧，能滿足行動裝置對高容量、小尺寸解決方案的需求。此次發布前，[美光採用 176 層 NAND 的 PCIe Gen4 固態硬碟已於六月量產供貨](#)，為專業工作站和超薄筆電提供高性能、設計彈性和低功耗等優勢。如今進一步應用於智慧型手機上，美光領先業界的先進 NAND 技術和性能將可透過跨應用程式的多工處理，為使用者實現更即時的行動體驗。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理 Raj Talluri 表示：「5G 為行動裝置提供數千兆位元的速度，其中，高性能硬體基礎對於驅動光速般的行動裝置體驗而言至關重要。藉由無與倫比的性能，美光突破性的 176 層 NAND 技術能在彈指之間為消費者帶來豐富的多媒體內容。」

美光的 176 層 UFS 3.1 解決方案提供較上一代快 15% 的混合工作負載效能，可以更快速地啟動和切換應用程式，提供更流暢的行動體驗。在沒有儲存裝置的瓶頸下，透過 UFS 3.1 介面和美光 176 層 NAND 的強大組合，使用者可以善用 5G 的高速優勢。

榮耀產品線總裁方飛表示：「榮耀的 Magic 3 系列是首款採用美光結合 UFS 3.1 介面和 176 層 NAND 高性能 3D NAND 解決方案的智慧型手機。受惠於美光領先業界的解決方案，榮耀旗艦機型 Magic 3 系列的使用者將能享受快速下載和儲存，以及即時、無縫的跨應用程式多工處理。」

美光 176 層 NAND 行動解決方案特色：

- **性能升級**：美光的 176 層 UFS 3.1 解決方案提供較前幾代快 75% 的循序寫入速度和快 70% 的隨機讀取速度，可顯著提升應用程式性能。
- **高速下载**：高達 1,500 MB/s 的循序寫入性能，能夠支援在 0.7 秒內[\[3\]](#)下載 10 分鐘的 4K (2,160 像素) YouTube 串流影片，或在 9.6 秒內下載兩小時的 4K 電影。
- **流暢體驗**：與前一代相比，美光的 176 層 UFS 3.1 解決方案及其優秀的服務品質可改善約 10% 的延遲，提供更快速的反應時間與更可靠的行動體驗。
- **更加強化的耐用**：與前代產品相比，美光 176 層行動解決方案提供兩倍的寫入總位元數，這代表在不降低裝置可靠性的情況下，[\[4\]](#)可以儲存兩倍的資料量，即使面對重度使用者，也可以延長智慧型手機的使用壽命。

美光 176 層 UFS 3.1 行動解決方案的可用性

美光 176 層 UFS 3.1 獨立行動通用快閃記憶體現已上市，有三種不同的容量配置：128GB、256GB 和 512GB。

相關連結

- 部落格：[World's Most Advanced Flash Memory Goes Mobile](#)

關於 Micron Technology, Inc.

我們是創新記憶體和儲存空間解決方案的業界先驅，正在改變世界使用資訊的方式，豐富所有人的生活。美光持續關注於客戶、技術優勢，以及製造和卓越營運，並透過美光 (Micron®) 和 Crucial® 品牌提供高效能的 DRAM、NAND 和 NOR 記憶體以及儲存產品的豐富系列產品。美光持續的創新推動了資料經濟、人工智慧和 5G 應用程式的進步，進而激發從資料中心到智慧終端以及客戶端和行動裝置使用者體驗等各種新的機會。如需有關 Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU) 的詳細資訊，請瀏覽 micron.com。

© 2021 Micron Technology, Inc. 保留所有權利。資訊、產品和 / 或規格若有變動，恕不另行通知。美光、美光標誌及其他所有美光商標皆為 Micron Technology, Inc. 資產。其他所有商標皆屬其各自擁有者所有。

美光媒體關係聯絡人

Steffi Lau
Micron Technology, Inc.
+1 (408) 834-1618
steffilau@micron.com

[1] 較於上一代美光 96 層 UFS 3.1 儲存裝置。

[2] 假設每部電影的檔案大小為 14GB。

[3] 假設影片的檔案大小為 1GB。

[4] 與採用美光浮閘式 96 層 NAND 的上一代 UFS 3.1 和停用寫入加速技術 (WriteBooster) 的 176 層產品進行比較。